Table I–3 to Subpart I of Part 98—Default Emission Factors ($1–U_{ij}$) for Gas Utilization Rates (U_{ij}) and By-Product Formation Rates (B_{ijk}) for Semiconductor Manufacturing for 150mm and 200 mm Wafer Sizes

Process Type/ Sub-Type	Process Gas i												
	CF_4	C_2F_6	CHF_3	CH_2F_2	C_2HF_5	CH_3F	C_3F_8	C_4F_8	NF_3	SF_6	C_4F_6	C_5F_8	C_4F_8O
ETCHING/ WAFER CLEANING													
$1-U_i$	0.81	0.72	0.50	0.13	0.064	0.51	NA	0.14	0.19	0.55	0.17	0.072	NA
BCF_4	NA	0.10	0.085	0.079	0.077	NA	NA	0.11	0.0040	0.13	0.13	NA	NA
BC_2F_6	0.046	NA	0.030	0.025	0.024	NA	NA	0.037	0.025	0.11	0.11	0.014	NA
BC_4F_6	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BC_4F_8	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BC_3F_8	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BC_5F_8	0.0012	NA	0.0012	NA	NA	NA	NA	0.0086	NA	NA	NA	NA	NA
$BCHF_3$	0.10	0.047	NA	0.049	NA	0.0034	NA	0.040	NA	0.0012	0.066	0.0039	NA
CHAMBER CLEANING													
In situ plasma cleaning													
$1-U_i$	0.92	0.55	NA	NA	NA	NA	0.40	0.10	0.18	NA	NA	NA	0.14
BCF_4	NA	0.21	NA	NA	NA	NA	0.20	0.11	0.050	NA	NA	NA	0.13
BC_2F_6	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.045
BC_3F_8	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Remote plasma cleaning													
$1-U_i$	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.018	NA	NA	NA	NA
BCF_4	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.015	NA	NA	NA	NA
BC_2F_6	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BC_3F_8	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
In situ thermal cleaning													
$1-U_i$	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BCF_4	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BC_2F_6	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BC_3F_8	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Notes: NA = Not applicable; i.e., there are no applicable default emission factor measurements for this gas. This does not necessarily imply that a particular gas is not used in or emitted from a particular process sub-type or process type.